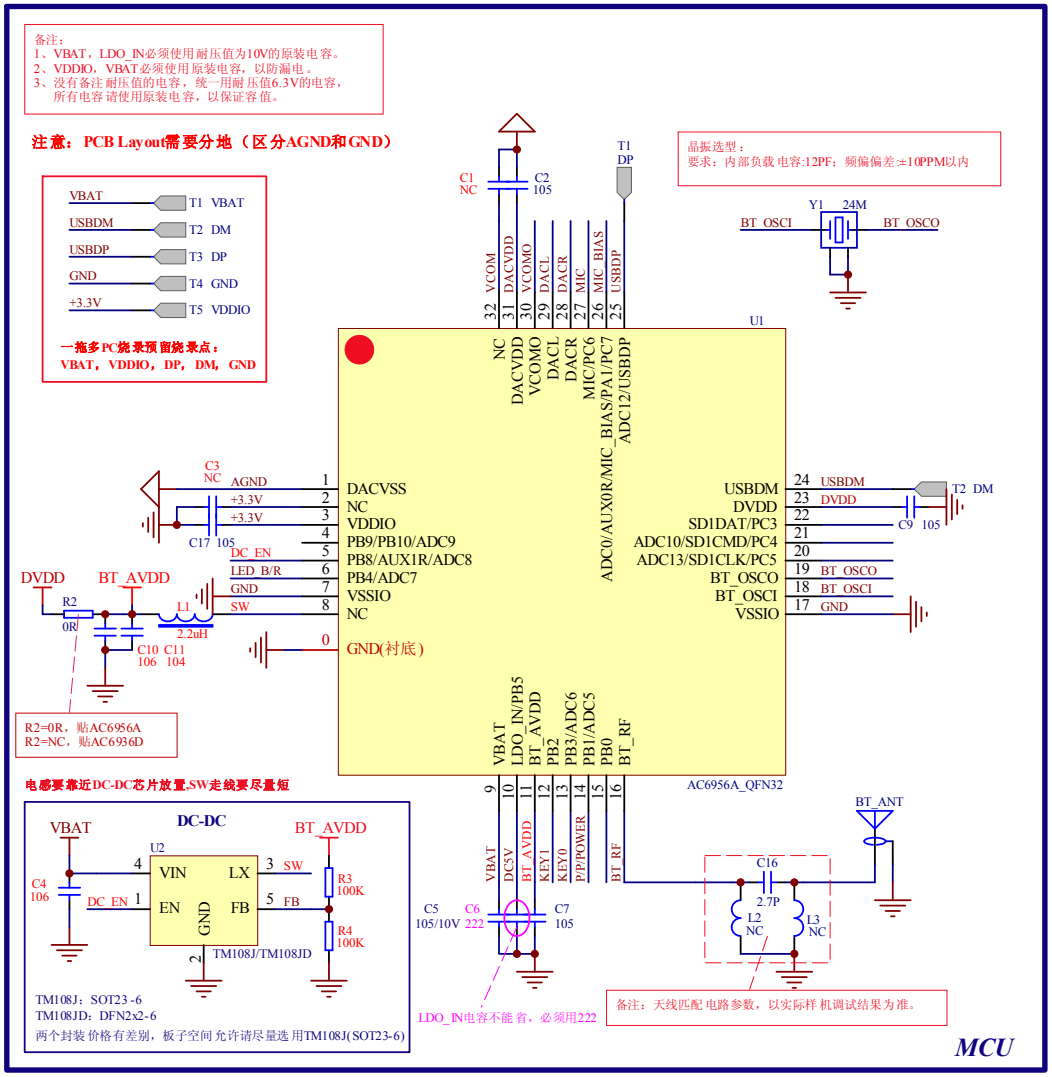
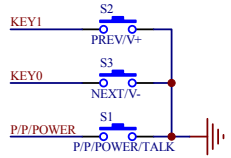
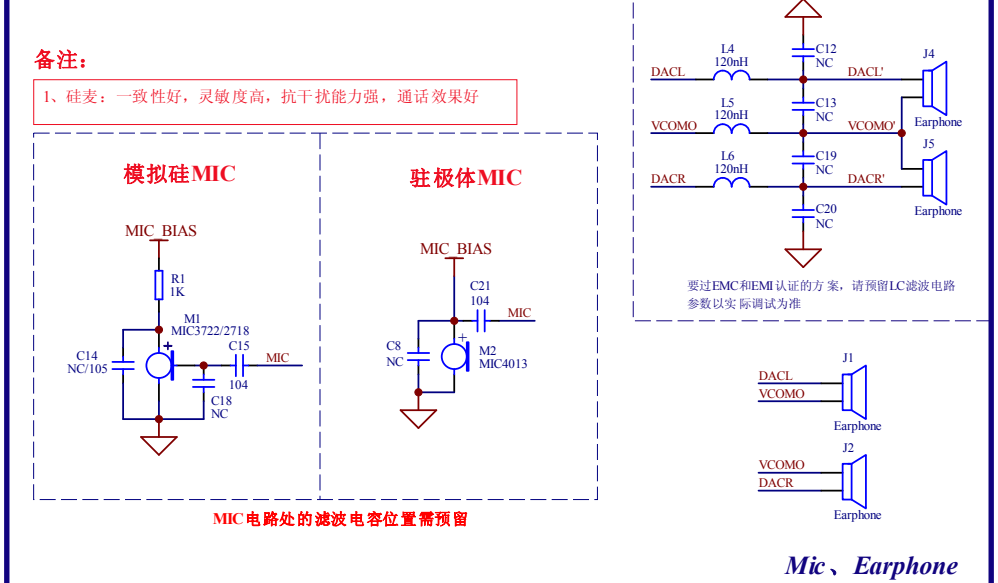
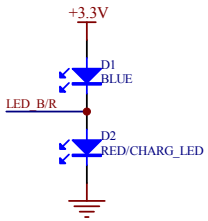
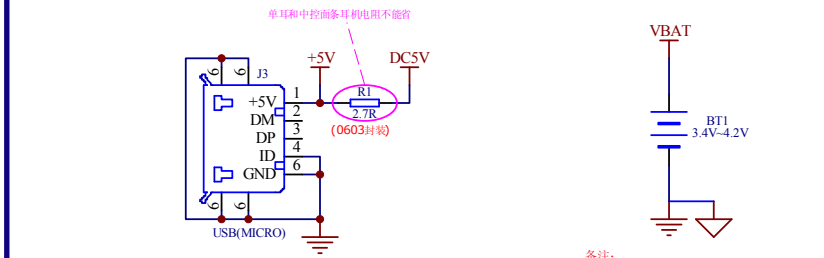

备注：
1、VBAT，LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容请使用原装电容，以保证容值。
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
VBAT T1 VBAT
USBDM T2 DM
USBDP T3 DP
GND T4 GND
+3.3V T5 VDDIO
一拖多PC烧录预留烧录点：
VBAT，VDDIO，DP，DM，GND
晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差±10PPM以内
Y1 24M
BT_OSCI
BT_OSCO
U1
DACVSS
NC
VDDIO
PB9/PB10/ADC9
PB8/AUX1R/ADC8
PB4/ADC7
VSSIO
NC
GND(衬底)
USBDM
DVDD
SD1DAT/PC3
ADC10/SD1CMD/PC4
ADC13/SD1CLK/PC5
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
ADC0/AUX0R/MIC_BIAS/PA1/PC7
ADC12/USBDP
VBAT
LDO_IN/PB5
BT_AVDD
PB2
PB3/ADC6
PB1/ADC5
PB0
BT_RF
AC6956A_QFN32
DC_EN
LED_B/R
GND
SW
R2=0R，贴AC6956A
R2=NC，贴AC6936D
电感要靠近DC-DC芯片放置,SW走线要尽量短
DC-DC
U2
VIN
LX
EN
GND
FB
TM108J/TM108JD
TM108J：SOT23-6
TM108JD：DFN2x2-6
两个封装价格有差别，板子空间允许请尽量选用TM108J(SOT23-6)
BT_ANT
LDO_IN电容不能省，必须用222
备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。
MCU


KEY1
KEY0
P/P/POWER
PREV/V+
NEXT/V-
P/P/POWER/TALK
KEY


备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
MIC_BIAS
R1
1K
M1
MIC3722/2718
C14
NC/105
C15
104
MIC
C18
NC
驻极体MIC
MIC_BIAS
C21
104
MIC
C8
NC
M2
MIC4013
MIC电路处的滤波电容位置需预留
DACL
VCOMO
DACR
L4
120nH
L5
120nH
L6
120nH
C12
NC
C13
NC
C19
NC
C20
NC
DACL'
VCOMO'
DACR'
J4
J5
Earphone
Earphone
要过EMC和EMI认证的方案，请预留LC滤波电路
参数以实际调试为准
J1
J2
Earphone
Earphone
Mic、Earphone


+3.3V
D1
BLUE
LED_B/R
D2
RED/CHARG_LED
LED


单耳和中控面条耳机电阻不能省
J3
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)
R1
2.7R
(0603封装)
VBAT
BT1
3.4V~4.2V
备注：
1、GND、AGND在电池地处短接在一起！
2、电池必须使用带保护板的电池
POWER